SSD で測定された Kr-84 のエネルギースペクトルと PHITS 計算の比較 ver.2

神原 正

2020 年 2 月 24 日-26 日に行われた M 社有償利用の際に測定された <sup>84</sup>Kr のエネルギースペクトルを PHITS による Simulation と比較した。

使用したスペクトルは 2 月 24 日に SSD で測定されたデグレーダ厚さ依存性で、rawdata のファイル名は scnEDssd1-0001.dmp から scnEDssd1-0022.dmp まで、デグレーダの厚さは 0 から 844.5  $\mu$  m まで、SSD は B1 と B2 である。

PHITS 計算で設定した物質層を以下の表と図 1 に示す。厚さは cnfd サーバにあるエクセルファイル①準備\_ED 選\_2002Kr(M01)\_200226.xlsm の params シートの値に基づく。

名称	材質	厚さ	位置 (mm)
散乱体	金	$45.8\mu$ m	-130
真空切り窓	カプトン	$78\mu$ m	0
電離箱窓・電極とシン	マイラ	89.4 $\mu$ m	30
チの遮光幕 (合計)			
電離箱電極	アルミ	$14\mu$ m	35
シンチ	プラスチックシンチ:	$100\mu$ m	50
	EJ-212 Polyvinyltoluene		
デグレーダ	アルミ	可変	145
大気	空気	365mm-固体層	0-365
試料	シリコン	2.05mm	365

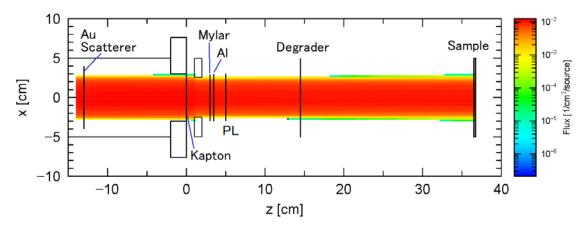


図1:PHITSで設定したビームと物質層の配置。

散乱体に Kr-84 の平行ビームを入射して、デグレーダの厚さを変えながら Si 試料に入射する Kr-84 イオンのエネルギー分布を[T-Cross]で計算した。

入射粒子のエネルギー分布は2種類設定した。すなわち68MeV/Aの単一エネルギー

## [Source]

proj = 84Kr # 入射粒子 e0 = 68 # energy of beam [MeV/u]

と 68MeV/A を中心とする半値全幅 0.36MeV/A のガウス分布で、ただし下限 67.64MeV/A から上限 68.36MeV/A の間に限定した。

## [Source]

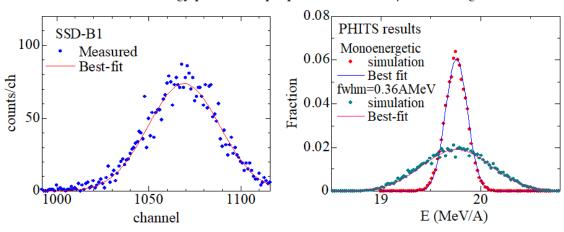
このビームエネルギー分布の中心値と幅の値は、計算結果が SSD の測定結果に一致するように選択した。入射粒子の個数は 20000 個とした。

それぞれのデグレーダ厚さに対して得られたエネルギースペクトルは、測定結果に対してはチャネル数、Simulation に対してはエネルギー(MeV/A)を変数 x として、高さ A、ピーク中心 $x_0$ 、幅  $\sigma$  をパラメータとするガウス関数

$$A\exp[-(x-x_0)^2/2\sigma^2]$$

で最小自乗近似した。

最小自乗近似の例として、デグレーダの厚さが  $446\,\mu$  m の場合に対する SSD - B1 の測定と PHITS の Simulation で得られたピーク付近のスペクトルを図 2 に示す。左のグラフが SSD の測定結果、右のグラフが PHITS による計算結果である。 PHITS 計算では入射粒子のエネルギー分布が単一エネルギーの場合とガウス分布の場合をともに示す。



Kr-84 energy peak at sample position after 648 µm-thick degrader

図 2: デグレーダ厚さ  $648 \mu$  m に対して SSD-B1 (左) と PHITS (右) で得られた Kr-84 のピーク付近のエネルギー分布。

PHITS の計算では、入射粒子を単一エネルギー分布からガウス分布にすると、ピーク位置はほとんど変わらないがピーク幅は大きくなる。

最小自乗法で得られたピーク中心と幅の最適値をデグレーダ厚さの関数としてプロットした結果を図3に示す。ただし左はSSD-B1で右はSSD-B2である。

それぞれ上の図はピーク中心位置で、赤丸が SSD によるチャンネル数で左の縦軸(Y 軸)が対応し、青丸が PHITS 計算によるエネルギー値(MeV/A)で右の縦軸(R 軸)が対応する。ただし PHITS 計算の入射粒子エネルギー(あるいはその中心値) はビームの飛程が SSD 測定に合うように調整した。その結果が 68 MeV/A である。またグラフの Y 軸と R 軸の尺度の比は SSD の測定結果と PHITS の計算結果が重なるように調整した。その結果エネルギーとチャネルの比は B1 で 0.01864、B2 で 0.0153 である。デグレーダの厚さによらずピーク位置は入射粒子のエネルギーが単一でもガウス分布でもほとんど同じである。

下の図はピーク幅 $\sigma$ で、Y 軸と R 軸の尺度の比は上のピーク位置のグラフの値と同じである。入射粒子が単一エネルギーとした PHITS のピーク幅は測定結果の 4 分の 1 程度であるが、エネルギーが半値全幅 0.36MeV/A のガウス分布になると仮定するとデグレーダの厚さ全体にわたって測定値によく合う。

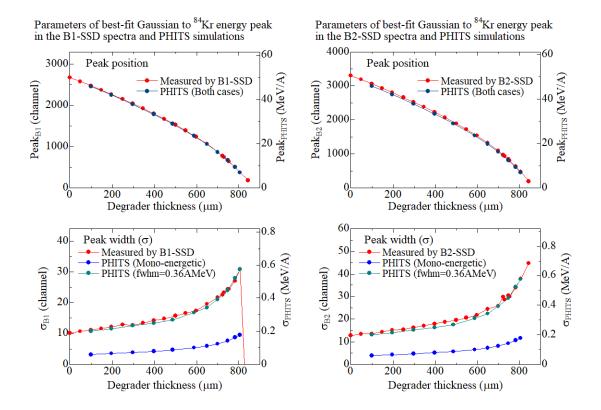


図 3: SSD-B1 (左) と B2 (右) のピーク中心 (上) と幅 (下) のデグレーダ厚さ依存性と PHITS による計算結果の比較。